

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成28年4月7日(2016.4.7)

【公開番号】特開2012-128860(P2012-128860A)

【公開日】平成24年7月5日(2012.7.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-026

【出願番号】特願2011-273503(P2011-273503)

【国際特許分類】

G 06 F 21/81 (2013.01)

G 11 C 16/02 (2006.01)

G 11 C 16/06 (2006.01)

【F I】

G 06 F 21/02 1 8 1 A

G 11 C 17/00 6 1 1 G

G 11 C 17/00 6 0 1 Z

G 11 C 17/00 6 3 2 A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年2月17日(2016.2.17)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

当該モジュールへの攻撃を検出するための手段と、

攻撃が検出されたときに、不揮発性メモリのセル(110、510)への書き込み動作を指令するために、プログラミング電圧(U_p)の印加可能なチャージポンプ(120)に充電することができる指令手段(130)と、

通常の動作の際に電力が供給され、攻撃が検出されたときにのみ前記チャージポンプ(120)へと電力を供給するように構成されたコンデンサ(140)とを備えており、

前記コンデンサ(140)が、攻撃が検出されたときに前記指令手段(130)にも電力を供給することを特徴とするモジュール(100、500、600)。

【請求項2】

前記指令手段(130)が、フリップフロップ(132)及びNOTゲート(134)を備えており、前記フリップフロップの出力が、通常の動作においては第1のレベルにあり、攻撃が検出されたときに第2のレベルにあり、前記第2のレベルが、前記書き込み動作の継続時間の全体において高のままであることを特徴とする請求項1に記載のモジュール(100、500、600)。

【請求項3】

前記セル(110)が、ワン・タイム・プログラマブル(OTP)セルであることを特徴とする請求項1又は2に記載のモジュール(100)。

【請求項4】

前記セル(510)が、EEPROMメモリのセルであることを特徴とする請求項1又は2に記載のモジュール(500、600)。

【請求項5】

制御信号(SC)を含んでおり、

前記制御信号(SC)のレベル(NH、NB)が前記セル(510)の書き込み又はブ

ランク状態を表わし、

前記制御信号（S C）が、攻撃が検出されたときに当該モジュール（500）の重要信号（S I V）を維持するために使用されることを特徴とする請求項4に記載のモジュール（500）。

【請求項6】

前記重要信号（S I V）が、リセット信号、クロック信号、又は当該モジュール（500）の外部の機器に接続された入力／出力信号の中から選択されることを特徴とする請求項5に記載のモジュール（500）。

【請求項7】

制御信号（S C）を含んでおり、

前記制御信号（S C）のレベル（N H、N B）が前記セル（510）の書き込み又はブランク状態を表わし、

前記制御信号（S C）が、当該モジュールの重要部品（150）への電力の供給を制御するスイッチ（T3）に対する指令に使用されることを特徴とする請求項4に記載のモジュール（600）。

【請求項8】

前記スイッチ（T3）が、PMOSトランジスタであることを特徴とする請求項7に記載のモジュール（600）。

【請求項9】

前記重要部品が、プロセッサ（150）であることを特徴とする請求項7に記載のモジュール（600）。

【請求項10】

ISO 7816規格によるマイクロ回路カードで構成される請求項1に記載のモジュール（100、500、600）。